

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

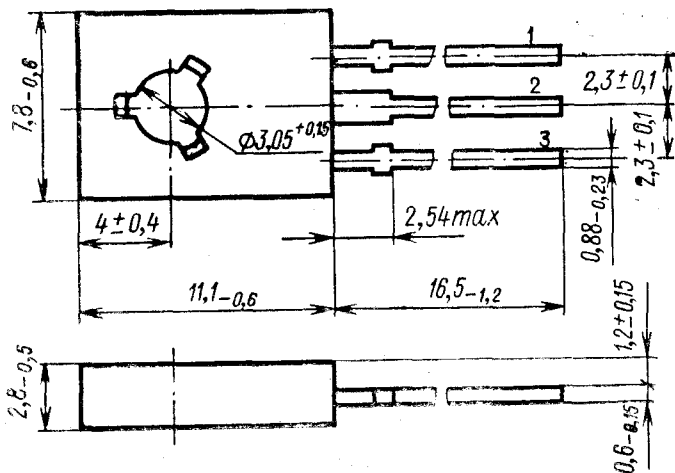
n-p-n

КТ817А—
КТ817Г

КТ817А

По техническим условиям АА0.336.187 ТУ

Основное назначение — работа в аппаратуре широкого применения.
Оформление — в пластмассовом корпусе.



- 1 — база
- 2 — коллектор
- 3 — эмиттер

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды, °С:

верхнее значение	+125
нижнее значение	—60

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические параметры

Обратный ток коллектора ($U_{КБ} = 25$ В), мА, не бо-

лее:

при $t_{кор} = 25 \pm 10^\circ \text{C}$	100
> $t_{кор} = 150 \pm 5^\circ \text{C}$	3

КТ817А—
КТ817Г

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

n—p—n

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($U_{КБ}=2$ В, $I_{Э}=1$ А), не менее:

при $t_{кор} = 25 \pm 10$ и $150 \pm 5^\circ$ С 25
» $t_{кор} = -60 \pm 3^\circ$ С 15

Напряжение насыщения ($I_{К}=1$ А, $I_{Б}=0,1$ А), В, не более:

коллектор—эмиттер 0,6
база—эмиттер 1,5

Граничное напряжение ($I=0,1$ А, $\tau_n \leq 300$ мкс, $Q > 100$), В, не менее 25

Пробивное напряжение эмиттер—база ($I_{Э}=1$ мА), В, не менее 5

Емкость перехода на частоте 1 МГц, пФ, не более:
коллекторного ($U_{КБ}=10$ В) 60
эмиттерного ($U_{ЭБ}=0,5$ В) 115

Граничная частота коэффициента передачи тока ($U_{КБ}=10$ В, $I_{Э}=250$ мА, $f=1$ МГц), МГц, не менее 3

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ *

Наибольшее постоянное напряжение, В:

коллектор—эмиттер 25
коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм 40
эмиттер—база 5

Наибольший ток коллектора, А:

постоянный 3
импульсный ($\tau_n \leq 20$ мс, $Q \geq 100$) 6

Наибольший постоянный ток базы, А 1

Наибольшая постоянная рассеиваемая мощность коллектора ($t_{кор} \geq 25^\circ$ С) Δ , Вт 25

Наибольшая температура перехода, $^\circ$ С 150

* При $t_{кор} = -60 \pm 100^\circ$ С.

Δ При $t_{кор} > 25^\circ$ С $P_{К макс}$ снижается линейно на 0,2 Вт/ $^\circ$ С.

$P_{К макс}$ без теплоотвода не более 1 В. При $t_{кор} > 25^\circ$ С эта мощность снижается линейно на 0,01 Вт/ $^\circ$ С.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка, ч 15 000

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 4, а изгиб — 5 мм корпуса с радиусом закругления не менее 1,5 мм.

Изгиб в плоскости выводов запрещается.

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

n-p-n

**КТ817А—
КТ817Г**

Следует принимать меры, исключающие передачу усилий на корпус. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

При эксплуатации в режиме, превышающем 1 Вт транзистор необходимо крепить на теплоотводе.

КТ817Б

Обратный ток коллектора ($U_{КБ} = 45$ В), не более:	
при $t_{кор} = 25 \pm 10^\circ$ С, мкА	100
» $t_{кор} = 150 \pm 5^\circ$ С, мА	3
Граничное напряжение, В, не менее	45
Наибольшее постоянное напряжение коллектор — эмиттер, В	45

Примечание. Остальные данные такие же, как у КТ817А.

КТ817В

Обратный ток коллектора ($U_{КБ} = 60$ В), не более:	
при $t_{кор} = 25 \pm 10^\circ$ С, мкА	100
» $t_{кор} = 150 \pm 5^\circ$ С, мА	3
Граничное напряжение, В, не менее	60
Наибольшее постоянное напряжение коллектор — эмиттер, В	60

Примечание. Остальные данные такие же, как у КТ817А.

КТ817Г

Обратный ток коллектора ($U_{КБ} = 100$ В), не бо- лее:	
при $t_{кор} = 25 \pm 10^\circ$ С, мкА	100
» $t_{кор} = 150 \pm 5^\circ$ С, мА	3
Граничное напряжение, В, не менее	80
Наибольшее постоянное напряжение, В:	
коллектор — эмиттер	80
коллектор — эмиттер при $R_B \leq 1$ кОм	100

Примечание. Остальные данные такие же, как у КТ817А.

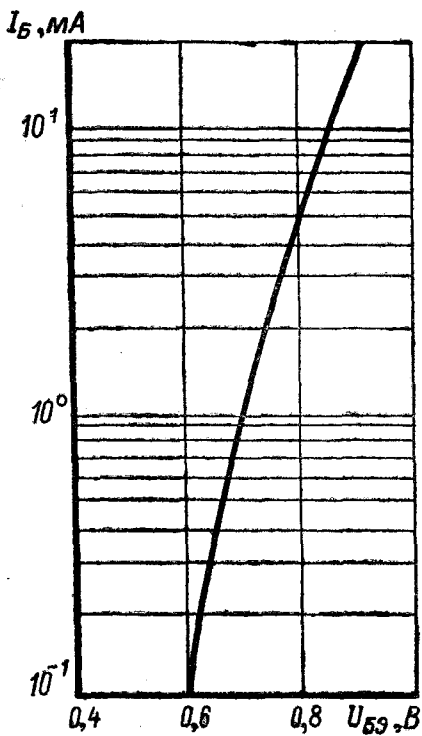
КТ817А—
КТ817Г

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

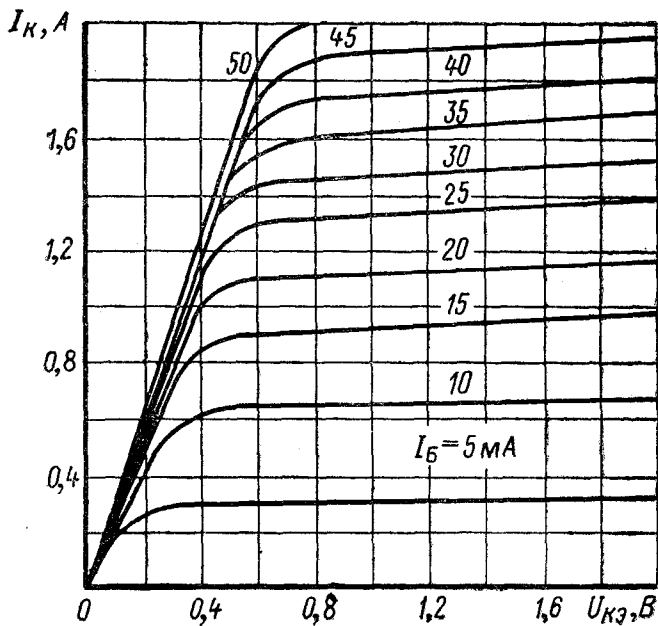
n-p-n

ТИПОВАЯ ВХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

(в схеме с общим эмиттером)



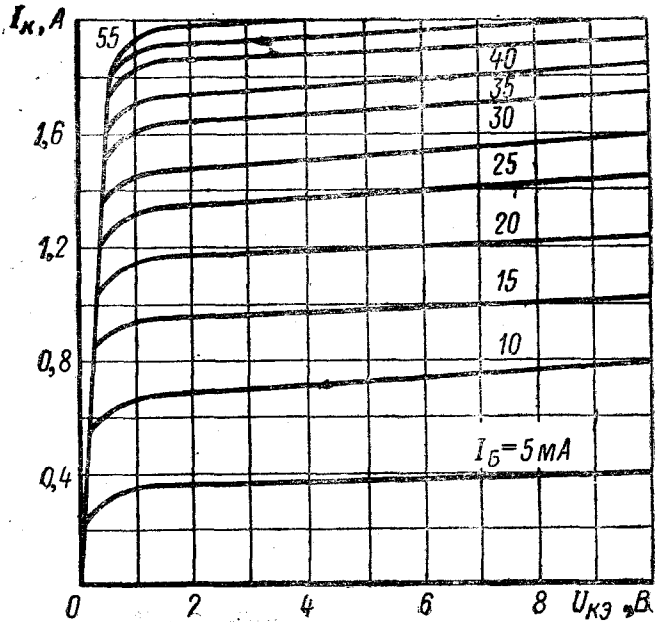
НАЧАЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ТИПОВЫХ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
(в схеме с общим эмиттером)



КТ817А—
КТ817Г

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
n—p—n

ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(в схеме с общим эмиттером)



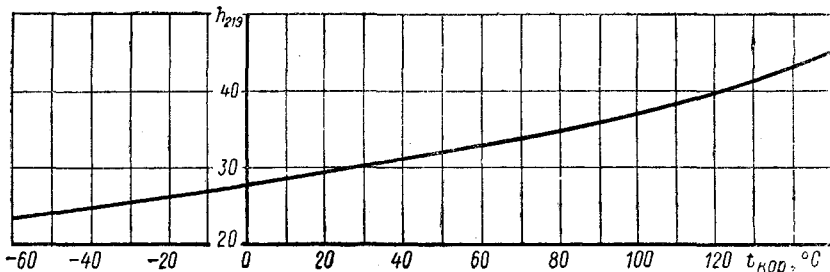
КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

n-p-n

КТ817А—
КТ817Г

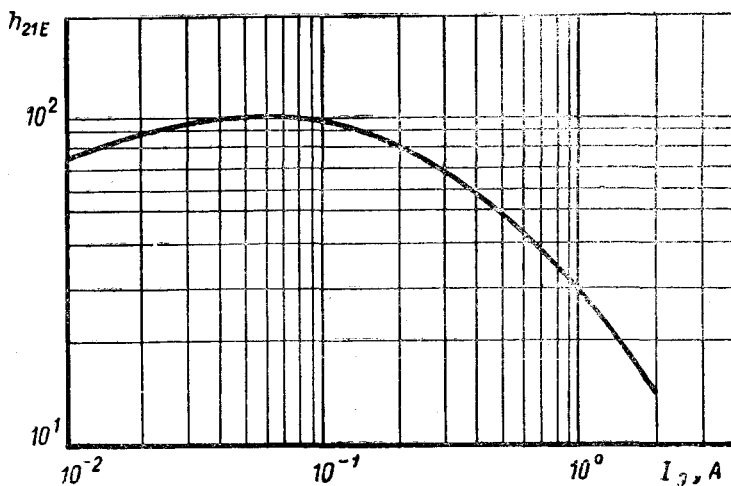
ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРПУСА

При $U_{КБ} = 2$ В и $I_{Э} = 1$ А



ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ ТОКА В СХЕМЕ С ОБЩИМ ЭМИТТЕРОМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА ЭМИТЕРА

При $U_{КБ} = 2$ В



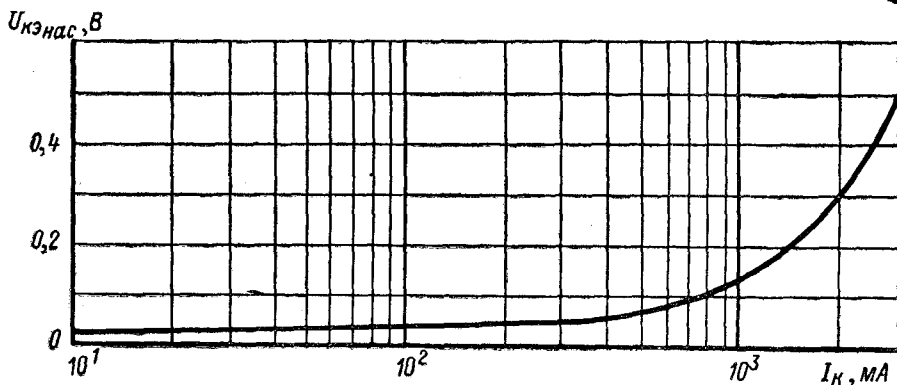
КТ817А—
КТ817Г

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

n-p-n

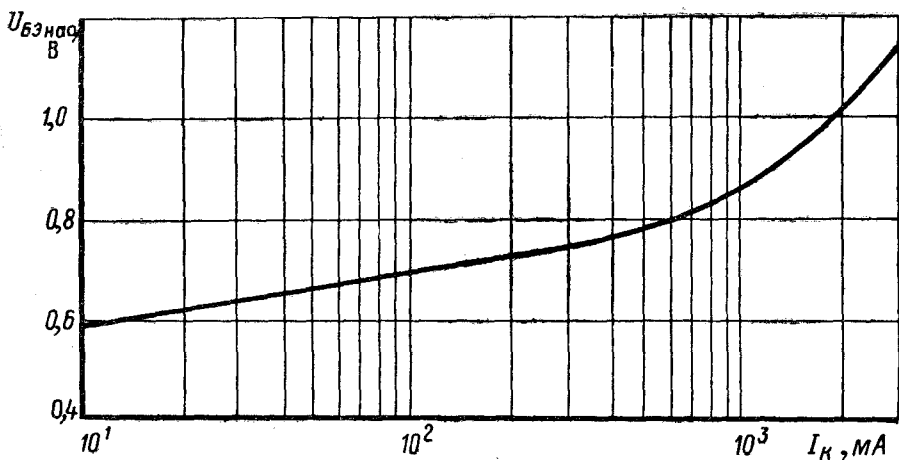
ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ
КОЛЛЕКТОР — ЭМИТТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА

При $\frac{I_K}{I} = 10$

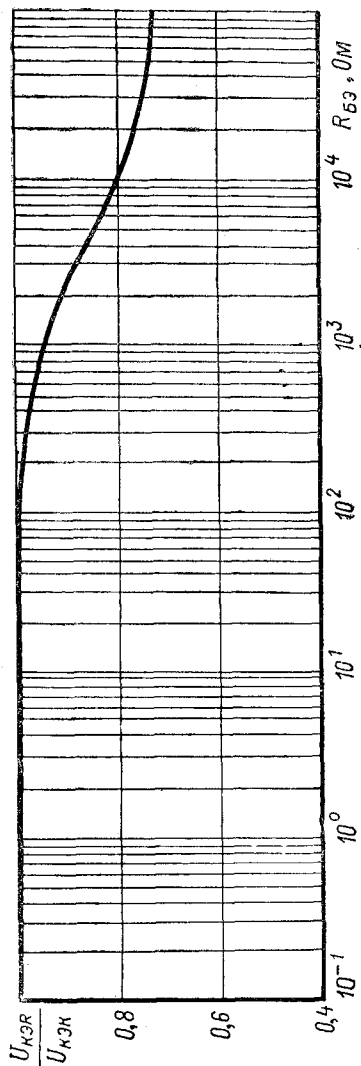


ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯЖЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ
БАЗА — ЭМИТТЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОКА КОЛЛЕКТОРА

При $\frac{I_K}{B} = 10$



ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОР — ЭМИТТЕР, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЦЕПИ БАЗА — ЭМИТТЕР



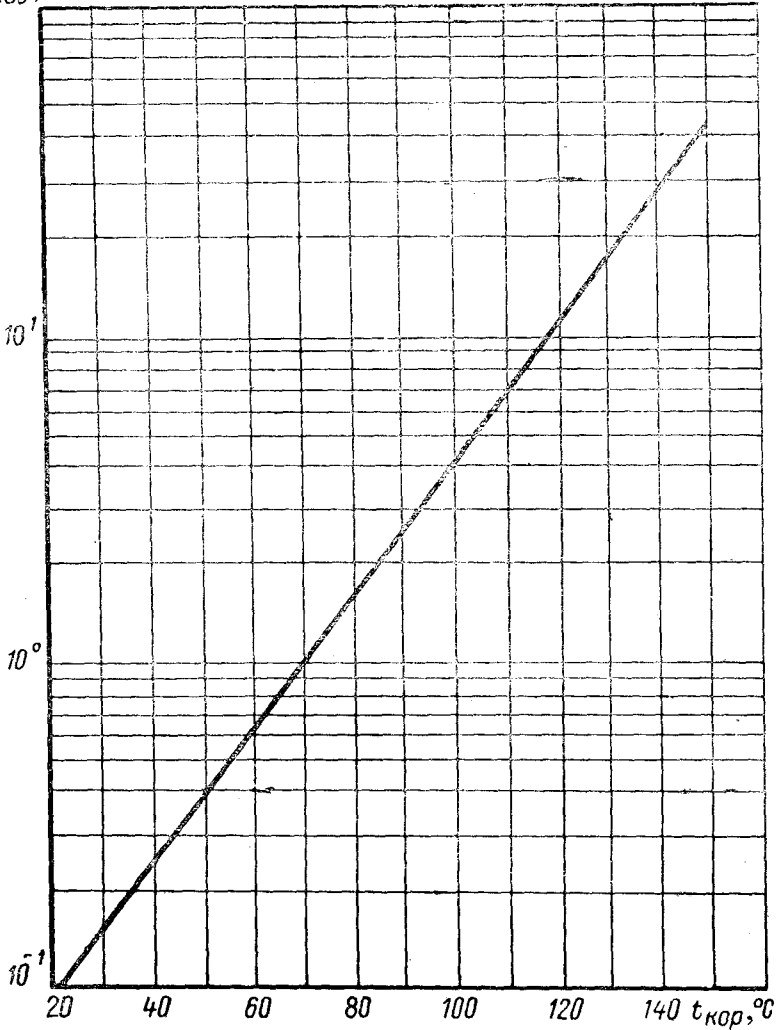
КТ817А—
КТ817Г

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

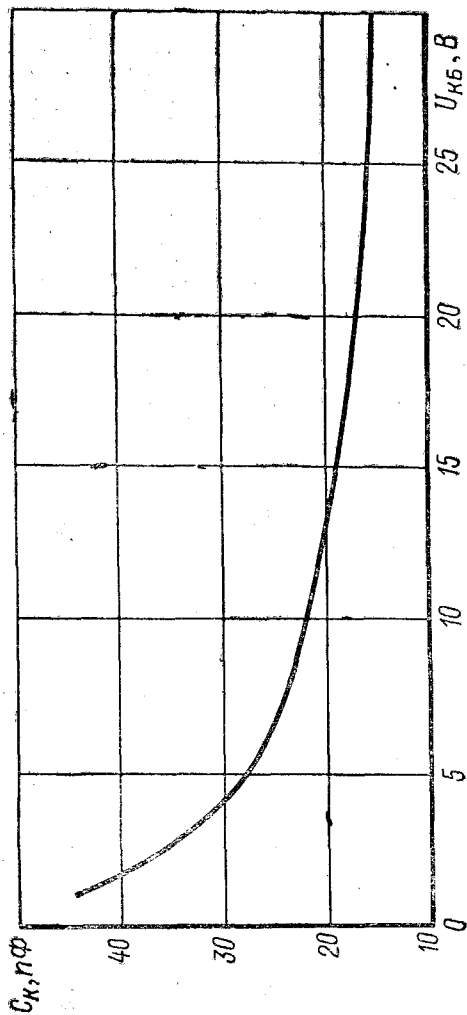
n-p-n

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАТНОГО ТОКА КОЛЛЕКТОРА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОРПУСА

$I_{к50}, \text{мкА}$



ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМКОСТИ КОЛЛЕКТОРНОГО ПЕРЕХОДА
НА ЧАСТОТЕ 1 МГц В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА



КТ817А—
КТ817Г

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

n-p-n

ОБЛАСТЬ МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ

